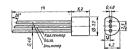
КТ503А, КТ503Б, КТ503В, КТ503Г, КТ503Д, KT503E

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п универсальные низкочастотные маломощные. Предназначены для работы в усилителях НЧ, операционных

лифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных

CYCMBY Выпускаются в пластмоссовом корпусе с гибкими выводами Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса траизистора не более 0,3 г.



Į	Каллентор 5ала 4,2 Электрические параметры	21
	HOUDERSHIP DON 1-10 MA 1 < 30 Mg	

скважности > 100 не менее KT503A, KT503B . . . 25 B 40 B

KT503B, KT503F . . КТ503Д . . . KT503F

60 B

90 B

80 - 240

I MKA

40 B

60 B

80 B

100 B

0.35 A

0,1 A

0.35 Ba 398 K

OT 233 до 358 К

5 B 0,15 A

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мA, I_E = I мА не более . . . 0,6 B 0,2 * B

типовое значение . Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{\rm K}=10$ 1,2 B 0,8* B

cvesse 40 - 120

Гланичная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K3} = 5$ В, $I_0 = 3$ MA не менее . 5 MΓn Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ B, f =20 11/0

= 465 кГц не более Обратный ток коллектора при $U_{KS} = U_{KS \text{ макс}}$ не боnee.

Предельные эксплуатационные данные Постоянное напряжение коллектор-база KT503A, КТ503Б KT503B, KT503F КТ503Д

KT503E Постоянное напряжение база-эмиттер Постоянный ток коллектора . . Импульсный ток коллектора при $t_R < 10$ мкс, Q > 100Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мошность Температура окружающей среды . KTSOJA

0,3

ž 0,2

0,1

- KT503E

KTSQ3E 0,15 0,1

коллектор-эмиттер

коллектора mne

0.25 KTS03A-

0,2

пустимой постоянной мощности рассеивания коллектора от тем-

пературы http://lampilich.narod.ru/ اه. HT503A 0.75

KR\$0.20

10

Зависимость статического коэф фициента передачи тока от тока

0.65 Зависимость напряжения насы-шения база-эмиттер от тока кол-

8,7